

高炉主槽における脱珪処理

(連続溶銑処理方法の開発-7)

日本钢管(株) 福山製鉄所 梶川脩二 大根 滉 岸本純幸 ○伊藤春男
技研 福山研究所 山田健三 岩崎克博

1. 緒言

高炉鋳床脱珪において投射法が他より脱珪酸素効率などの反応面で優れていることはすでに報告¹した。しかし、投射を行う最適な場所、あるいは最適な反応槽形状などに関しては限られた鋳床スペース、発生スラグ処理の面で、今後の検討課題として残されていた。そこで、脱珪反応効率、除滓、将来の発展性を考慮して、それらについて検討を加えた。

2. 投射法における槽内脱珪挙動

Fig. 1 に示す脱珪反応槽において、脱珪剤投射位置近傍のサンプリングを行い、脱珪挙動を詳細に調査した。脱珪剤を Fig. 1 (A) 点で投射した場合(TIM)と上置きした場合(SFM)の [Si] 变化を Fig. 2 示したが、SFM では反応が緩慢であり、10m 以上の反応距離を要するのに対して、TIM では投射直下で反応が大巾に進行し、600mm 下流でほとんど反応が終了していた。このことより、脱珪反応に要する反応槽は極めて狭いスペースで設置可能であることが明らかになった。

3. 主槽での投射脱珪

溶銑槽での脱珪テスト結果を受けて主槽での投射脱珪を行った。この方法は高炉スラグ槽入口の上流 2.5m にランスをセットし (Fig. 1 (B) 点) 投射を行った。発生した脱珪スラグは、高炉スラグと混合されスラグ槽から排出した。得られたテスト結果を Fig. 3 に示す。溶銑槽で投射した結果とはほぼ同等の反応効果を得ることができた。また鍋およびトーピード脱珪処理時に問題となるスラグ泡立現象も皆無となつた。その他、ランス高さの影響、復硫等が知見として得られた。

4. 結言

投射法によれば脱珪反応が投射直下でほぼ終了するため、その近傍に排滓口、槽を配置し得る。投射位置を主槽ないしその近傍に置けば排滓は高炉津槽を利用できる。

1) 中村ら : 鉄と鋼 6 8 (1982) S 946.

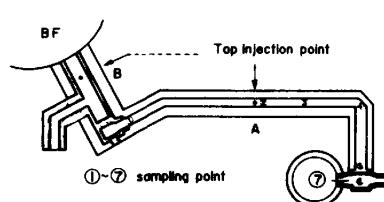


Fig. 1 Layout of BF cast house runner and the injection and sampling point.

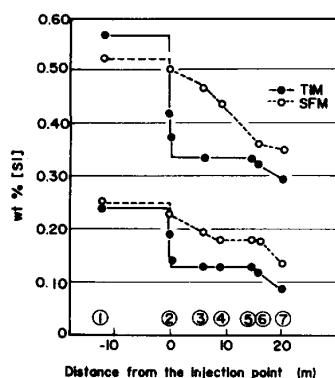


Fig. 2 Change of silicon content in the hot metal.

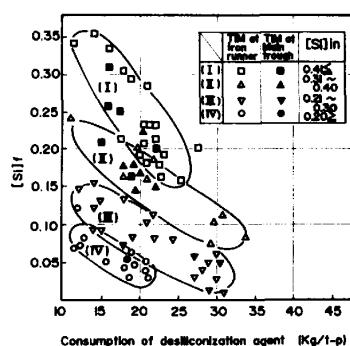


Fig. 3 Hot metal silicon content after the TIM treatment, $[Si]_f$, and the consumption of desiliconization agent.